www.nanomeghyas.ir سال دوم اشبارهی چهارم ازمستان ۱۳۹٤

نانومقياس

ساخت کاتد دمای پایین بازیرلایه ی کروم برای سلول خورشیدی رنگدانه ای

فاطمه بهروزنژاد` | نیما تقوینیا`'

۱.دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو ۲.دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک

چکيده

یکی از چالشهای مهم در حوزه ی سلول های خورشیدی نانوساختاری، ساخت الکترود با استفاده از فرآیندهای دمای پایین است تا علاوه بر کاهش پیچیدگی و هزینه ی ساخت، بتوان در ادامه از آن ها برای ساخت سلول های خورشیدی انعطاف پذیر استفاده کرد. در این پژوهش، کروم لایه نشانی شده به روش الكتروشيميايي، به عنوان زيرلايه ي كاتد معرفي شده است . بيشتر بودن میدان الکتریکی روی لبهها و نقصهای ایجاد شده روی اين زيرلايه، هنگام لايه نشاني پلاتين به روش الكتروشيميايي، باعث توزيع يكنواخت تر نانوذرات پلاتين روى سطح الكترود و درنتیجه افزایش سطح مؤثر آن می شود. با استفاده از این کاتد، علاوه بر امکان ساخت در دمای پایین، امکان ساخت در ابعاد بزرگ نیز ایجاد میشود (به دلیل مقاومت سری کم فلز کروم در مقایسه با زیرلایه ی FTO). در نهایت، اثر استفاده از کروم به عنوان زیرلایه ی کاتد با اثر استفاده از آن به عنوان زیرلایه ی فوتوآند در بازدهی و محدودیتهای ساخت، مقایسه و بررسی شده است. با استفاده از این کاتد دمای پایین در سلول خورشیدی رنگدانه ای، بازدهی ٪۹/۴۹ به طور میانگین به دست آمد.

واژگان کلیدی: سلول خورشیدی رنگدانهای، لایهنشانی الکتروشیمیایی، مقاومت انتقال بار، مقاومت سری، نانوذرات پلاتین

۱ مقدمه

انرژی خورشید، انرژی پاک، ارزان، در دسترس و تجدیدپذیر است که در مساحت زیاد ولی با چگالی کم به سطح زمین میرسد. چالش مهم در حوزهی سلولهای خورشیدی تبدیل این انرژی به انرژی الکتریکی با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه است.

اگر چه گزارشهای منتشر شده در سطح بین المللی، دربارهی بررسی بازدهی سلولهای خورشیدی با مساحت کم (در حد ۰/۱ cm² است، در مرحله ی کاربردی، فرآیندها و فناوریهایی کارآمد هستند که قابلیت استفاده در ابعاد بزرگ با هزینه و پیچیدگیهای ساخت کم را داشته باشند. سلولهای خورشیدی رنگدانه ای به دلیل کمینه بودن پیچیدگی و هزینه ی ساخت در مقایسه با همهی انواع سلول خورشیدی (به ویژه سلول های خورشیدی سیلیکونی) و نیاز نداشتن به فناوری های لايه نشاني در خلاً كه هم يرهزينه هستند و هم قابليت ساخت در ابعاد بزرگ را از سازنده می گیرند، مورد توجه قرار گرفته اند. سلول خورشیدی رنگدانه ای شامل یک فوتوآند و کاتد است که به طور معمول با یک پلیمر ترمو پلاست از هم فاصله می گیرند و بین آن ها با الكتروليت كه به طور متداول داراي جفت اكسايشي-كاهشي --Ir^{−−} است، پر می شود. ساختار متداول فوتوآند، یک زیر لایه ی رسانای شفاف است که روی آن لایه ی نازکی از نانوذرات سینتر شده ی تیتانیا (یا روی دی اکسید) قرار دارد و مولکول های رنگدانه روی آن جذب سطحی شدهاند. ساختار رایج کاتد، یک زیرلایه ی رسانای شفاف است که نانوذرات پلاتین روی آن به روش لایه نشانی تجزیه ی حرارتی ایجاد می شوند.

هنگام تابش نور به سلول، الکترون از بالاترین تراز پر شده ی رنگدانه^۲ به پایین تراز پرنشده ی آن^۳ برانگیخته و به به نوار هدایت نیمه هادی مورد نظر تزریق می شود و بنابراین بخش بزرگ تری از طیف در ناحیه ی جذب سلول قرار می گیرد. یون های اکسایشی-کاهشی داخل الکترولیت با سطح انرژی کمی بالاتر از سطح انرژی بالاترین تراز اشغال شده ی رنگدانه نقش انتقال

I. Redox

^{2.} Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO) 3. Lowest Unoccupied Molecular Orbital (LUMO)

^{5.} Lowest onoccupied Molecular Orbital (Low

حفره از این تراز به الکترود مقابل را دارند و به این ترتیب چرخه ی سلول کامل میشود[۱].

در هر دو الکترود، دو مورد محدود کننده وجود دارد، مورد اول استفاده از زیرلایه های رسانای شفاف است. برای مثال برای فوتوآند، به دلیل عبور نور از این زیرلایه برای رسیدن به ماده ی جاذب نور، نیاز است که شفافیت آن بیشینه باشد، بنابراین باید ضخامت لایه ی FTO کمینه باشد، اما این کاهش ضخامت باعث افزایش مقاومت سری سلول و اتلاف به ویژه در سلول و ماژول با ابعاد بزرگ میشود. مورد محدود کننده ی دوم، نیاز به دمای بیش از C[°] ۴۰۰ برای ساخت این الکترودها است که علاوه بر افزایش پیچیدگی ساخت، امکان ساخت روی زیرلایه های پلیمری انعطاف پذیر مثل PET^{*} و PEI[°] را سلب میکند. بنابراین در این پژوهش به دنبال استفاده از فرآیندهای لایه نشانی در دمای پایین، لایه نشانی زیرلایه و نانو ذرات پلاتین به روش الکتروشیمیایی هستیم.

مشکل دیگر استفاده از FTO لایه نشان ی شده روی شیشه، قیمت بالای آن است که بخش عمدهی قیمت سلول را در بر می گیرد[۲]. جایگزین کردن این زیرلایه با زیرلایه های ارزان قیمت فلزی، به دلیل خورنده بودن الکترولیت بریایه ی ید، با چالش مواجه است چرا که الکترولیت بر پایه ید، بسیار خورنده است و با بسیاری از فلزات مانند نقره[۳]، طلا[۳]، آلومینیوم[۳] [۴]، مس[۴و۵]، روی[۶] و آهن[۶]، بالادیم[۷] و همچنین آلیاژهایی مثل استیل کربنی[۶] واکنش می دهد. در مورد فلز نیکل واستیل زنگ نزن مشکل خوردگی بحث برانگیز است[۵و۸-۱۱]. فلز تیتانیم در این الکترولیت پایدار است و به صورت لایه ی نازک لایه نشانی شده به روش اسیاترینگ[۱۲–۱۴]، توری و ورقه ی نازک[۱۵] به عنوان زیرلایه در این سلول ها مورد استفاده قرارگرفته است، اما تیتانیم قیمت بالایی دارد و از نظر صرفه ی اقتصادی مناسب نیست. مشکل دیگر استفاده از فلز زیاد بودن جریان تاریک در مواردی است که فلز به عنوان زیرلایه ی فوتوآند استفاده می شود. همچنین آب بندی سلول با زیرلایه ی فلزی دشوار است.

در این مقاله فلز کروم به عنوان فلزی که در الکترولیت خورنده ی بر پایه ی ید این سلول ها پایدار است[۱۵،۱۶] به عنوان زیرلایه برای الکترود سلول خورشیدی رنگدانه ای معرفی می شود

تا علاوه بر کاهش مقاومت سری سلول، امکان لایه نشانی روی زیرای ایکان داد. زیرلایه ها و فویل های ارزان قیمت تراز FTO را برای ما ایجاد کند.

۲ بخش تجربی مواد و تجهیزات

از لایه ی نازک کروم به ضخامت ۲۰۰ نانومتر و لایه ی رسانای شفاف FTO روی شیشه، به عنوان زیرلایه ی رسانا برای لایه نشانی کروم به روش الکتروشیمیایی استفاده شد. محلول مورد استفاده برای لایه نشانی کروم شامل کرومیک اسید (۲۰۱ gL⁻¹–Merck) H_2SO_4 (۲/۱ gL⁻¹–Merck) بدون یون بود.

از خمیر نانوذرات 20 نانومتری تیتانیا (شریف سولار) برای ایجاد لایه ی جاذب رنگدانه ی N719 (Dyesol) استفاده شد. (Merck) H₂PtCl₆.6H₂O (Merck) برای ساخت محلولهای پلاتین استفاده شد. مورفولوژی سطح لایه ها با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نوری (VEGA-TESCAN) بررسی شد. نمودار چگالی جریان– ولتاژ سلول های ساخته شده با استفاده از شبیه ساز طیف خورشید (Sharif Solar SIM-1000) و پتانسیواستات (Palmsens) اندازه گیری شد.

روش آزمایش

لایه نشانی کروم به روش الکتروشیمیایی و با استفاده از سیستم دو الکترودی (الکترود سرب به عنوان الکترود مقابل) انجام شد. هنگام لایه نشانی محلول در حمام آب با دمای ۲۰۵۵ قرار داده شد و چگالی جریان لایه نشانی ۲۵۰۰ Acm قرار داده شد.

کروم به عنوان زیرلایهی فوتوآند

برای لایه نشانی لایه ی متراکم تیتانیا از سل یک درصدوزنی تیتانیا در آب و از روش لایه نشانی چرخه ای استفاده شد. از آن جا که میخواهیم لایه ی متراکم تیتانیم دی اکسید، قبل از تشکیل لایه ی کروم اکسید روی سطح کروم لایه نشانی شود، به محض این که لایه ی کروم را روی صفحه ی دستگاه لایه نشان چرخش ی قرار دادیم قبل از این که لایه به طور کامل پخش شود، سطح آن را با سل آمورف یا سل کریستال ی پوشاندیم. زمان چرخش ۴۰ ثانیه، سرعت آن ۵۵۰۰ و زمان رسیدن به این سرعت ۲۰ ثانیه تعیین شد. خمیر تیتانیا به روش دکتربلید لایه نشانی شد. لایه ها در دمای ۲۰۷۰ در منتر ما مدت ۳۰ دقیقه سینتر شدند.

برای ساخت فوتوآند به روش متداول، ابتدا یک لایهی متداول، ابتدا یک لایهی متراکم تیتانیا با استفاده از عملیات TiCl₄، لایه نشانی شد و بعد از شست و شو با اتانول در دمای C^{on} ۲۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه سینتر شد.

ساخت کاتد به روش تجزیهی حرارتی

روش متداول برای ساخت کاتد، قرار دادن یک قطره محلول FTO روش متداول برای H_2PtCl_6.6H_2O (ΔmM) و حرارت دهی تا دمای ۴۵۰ $^\circ C$

ساخت کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم

برای ساخت کاتد دمای پایین، لایههای کروم بعد از لایه نشانی و شست و شو وارد محلول لایه نشانی پلاتین (۵۰mM) و KNO₃ (۵۰mM)) میشوند. لایه نشانی به روش سه الکترودی، با الکترود Ag/AgCl به عنوان الکترود مرجع انجام شد.

ساخت سلول

کاتد و آند مورد نظر به موازات هم در حالی که لایه ی ۶۰ میکرومتری از یک پلیمر ترموپلاست بین آن قرار گرفته (Surlyn) در حرارت C° ۱۱۰ به مدت ۲ دقیقه حرارت می بیند، الکترولیت Z960 از سوراخ ایجاد شده در کاتد تزریق می شود و بعد محل سوراخ بسته می شود.

۳ نتایج و بحث

از آن جا که نور باید از یک الکترود (فوتوآند یا کاتد) وارد سلول خورشیدی رنگدانه ای شود، مجازیم که زیرلایه ی یکی از الکترودها را فلزی کنیم. از آن جا که نیاز است نانوذرات نیمه هادی جاذب رنگدانه (تیتانیا یا روی دی اکسید) به هم سینتر شده باشند و همچنین پلیمر ایجاد کننده ی تخلخل در لایه به طور کامل حذف شود، حرارت دهی تا دمای بالاتر از ۲[°] ۴۰۰ مورد نیاز است. بنابراین برای سلول های خورشیدی انعطاف پذیر که امکان حرارت دهی تا این دما وجود ندارد بهتر است زیرلایه ی فوتوآند فلزی باشد. به دلیل تشکیل یک لایه ی نانومتری متراکم اکسیدی روی سطح کروم، این قلز در الکترولیت بر پایه ی ید پایدار است بنابراین در این مقاله از فلز کروم استفاده شده است. در شکل (۱) نمودار چگالی جریان – ولتاژ این سلول ها نمایش داده

تشکیل لایه ی اکسیدی پکیده روی سطح کروم ، مانع بازترکیب الکترونهای کروم فلزی با یونهای ¬I داخل الکترولیت و درنتیجه کاهش ولتاژ مدار باز شده است . نکته ی قابل توجه این است که در صورتی که لایه ی متراکم چند ده نانومتری تیتانیا روی زیرلایه ی کروم لایه نشانی نشود ، ضریب پرکنندگی و درنتیجه بازدهی به دلیل زیاد شدن مقاومت سری سلول (عکس شیب نمودار جریان–ولتاژ در ولتاژ مدار باز سلول) به میزان قابل توجهی کم می شود . این امر نشان می دهد که وجود لایه ی تیتانیا متراکم روی سطح کروم ، ضخیم شدن لایه ی اکسیدی کروم روی سطح در فرآیند حرارت دهی در دمای بیش از ℃ ۴۰۰ را کند می کند. تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح کروم لایه نشانی شده به روش الکتروشیمیایی و لایه ی متراکم تیتانیا روی آن در شکل (۲)



شکل ۲) نمودار چگالی جریان -ولتاژ برای سلولهای خورشیدی با زیرلایهی کروم به عنوان زیرلایه ی فوتوآند یا زیرلایهی کروم به عنوان زیرلایهی کاتد. سلولهای با زیرلایه FTOروی شیشه (برای هر دو الکترود) به عنوان شاهد نمایش داده شدهاند. عناوین اختصاری و شرایط ساخت هر یک از سلولها در جدول شرح داده شده است.



شکل ۲) تصویر میکروسکوپ الکترونی از کروم لایهنشانی شده به روش الکتروشیمیایی (a)، لایهنشانی لایهی متراکم چند ده نانومتری تیتانیا روی آن که به عنوان زیرلایه برای فوتوآند به کار میرود (d) و لایه نشانی پلاتین به روش الکتروشیمیایی روی آن به عنوان کاتد دمای پایین برای سلول خورشیدی رنگدانه ای (c).

در شکل (۳) مشاهده میکنید که استفاده از سل تیتانیا برای لایه نشانی لایه ی متراکم روی سطح کروم (به عنوان جایگزینی برای عملیات ₄TiCl) باعث انتقال سریعتر الکترونها به مدار خارجی شده است. اگر چه با استفاده از لایهنشانی لایه ی متراکم تیتانیا، ضریب پرکنندگی به میزان قابل توجهی افزایش مییابد ولی چگالی جریان و بازدهی سلول با حد بهینه ی به دست آمده برای سلولهای خورشیدی رنگدانه ای فاصله دارد.



شکل ۳ ♪ (مان انتقال الکترون ها در لایهی تیتانیا به ضخامت ۳۰۵ میکرومتر که با استفاده از آنالیز IMPS اندازه گیری شده است. لایهی متراکم تیتانیا در مورد زیرلایه ی FTO به روش عملیات ۲iCl و در مورد کروم با یک بار (Cr−1S) و دوبار (Cr−2S) لایه نشانی سل تیتانیا (یک درصد وزنی) به روش لایه نشانی چرخشی ایجاد شده و در مقایسه با سلول با زیرلایه ی کروم برای فوتوآند و بدون لایهی متراکم.

ازجمله دلایل کم بودن چگالی جریان می توان مواردزیررانام برد.

 نور از سمت کاتد وارد سلول می شود، بنابراین بخشی از آن به وسیله ی نانوذرات پلاتین روی لایه ی FTO و همین طور الکترولیت بین دو الکترود، قبل از رسیدن به فوتوآند جذب می شود. همچنین امکان استفاده از لایه ی پراکنده گر تیتانیا در پشت لایه ی شفاف وجود ندارد.

• به دلیل این که یونهای کلر موجود در محلول TiCl₄ میتوانند با کروم واکنش دهند، از عملیات TiCl₄ دوم که باعث غیرفعال کردن باندهای آویزان روی سطح نانوذرات تیتانیا و اتصال بهتر آنها به هم میشود نمیتوان استفاده کرد و عملیات دیگری را باید جایگزین کرد.

 در ساختار معمول، نور از سمت فوتوآند وارد سلول می شود (شکل (a-4))، همان طور که در شکل نمایش داده شده است بخش قابل توجهی از نور در نزدیکی سطح FTO جذب و با عث تزریق الکترون از رنگدانه به تیتانیا می شود. اما در ساختاری که زیرلایه ی فوتوآند فلزی است، نور بعد از عبور از الکترولیت به فوتوآند می رسد و بخش عمده ی آن در جایی از لایه ی تیتانیا که از فوتوآند دورتراست جذب و به لایه ی تیتانیا تزریق می شود، بنابراین در این حالت، الکترون ها باید مسیر بیشتری را برای رسیدی به مدار خارجی طی کنند (شکل (b-4)) و در صورتی که نانوذرات تیتانیا اتصال خوبی به هم نداشته باشند، اتلاف زیاد خواهد بود.



مکل ۲۹۲۲ طرحواره ای از سلول خورشیدی در تابش از سمت فوتوآند (۵) و ازسمت کاتد (۵): در حالت اول، به طور متوسط الکترونهای تزریق شده به لایهی تیتانیا، مسیر کم تری را تا رسیدن به زیرلایه ی FTO و مدار خارجی باید طی کنند. در صورتی که اتصال نانوذرات تیتانیا به هم ضعیف باشد، اتلاف در حالت طقابل توجه خواهد بود.

بنابراین در موردی که فقط فلزی بودن یکی از زیرلایه ها مورد نظر باشد و ساخت سلول های انعطاف پذیر مورد نظر نباشد، برای کمینه کردن اتلاف بهتر است زیرلایه ی کاتد فلزی شود. برای کاهش مقاومت انتقال بار روی سطح کاتد، لایه نشانی پلاتین بلافاصله بعد از لایه نشانی کروم انجام شد. برای ساخت کاتد در دمای پایین، از لایه نشانی پلاتین به روش الکتروشیمیایی به جای روش تجزیه ی حرارتی استفاده شد.

برای لایه نشانی الکتروشیمیایی پلاتین، محلول لایه نشانی با غلظت کم (۳mM) H₂PtCl₆.6H₂O مورد استفاده قرار گرفت تا رشد نانوذرات آهسته تر باشد و از رشد ناگهانی جلوگیری شود. نوع نمکی که به عنوان انتقال دهنده ی میدان الکتریکی در محلول مورد استفاده قرار می گیرد تعیین کننده ی مورفولوژی سطحی

لایه است. برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در سطح فلز کاتد، از نمکهای دارای کلر مانند KCl استفاده نشد و از نمک KNO₃ استفاده شد. هدف، ایجاد مورفولوژی از پلاتین روی سطح است که باعث ایجاد بیشترین فعالیت الکتروکاتالیستی با مصرف کمینه مقدار پلاتین شود. بنابراین از لایه نشانی چرخه ای برای لایه نشانی پلاتین استفاده شد.

جدول ۱ 🚺 ویژگیهای مشخصهی سلولهای ساخته شده با کاتدهای Cr-Pt در دمای ۲۰۰۶ و ۲۵۵۵ در مقایسه با FTO-FT با پلاتیم لایه نشانی شده به روش تجزیهی حرارتی، فوتوآندها دارای لایهی پراکندهگر تیتانیا با سایز ۲۵۰–۱۵۰ نانومتر هستند.

و نرخ جاروب ولتاژ قابل کنترل است. وقتی پتانسیل از ۰٫۲ ولت کم تر میشود، (Pt(IV به (II) و بعد به پلاتین فلزی کاهش مییابد. همان طور که پتانسیل منفی تر میشود (کم تر از حدود ۰٫۶ ولت) نرخ کاهش (Pt(II به پلاتین فلزی) به سرعت افزایش مییابد و نانوذرات پلاتین تشکیل میشوند (شکل (۵)).

در پتانسیل هایی که اندکی از قله ی کاتدی کم تر است، جریان با نفوذ یون ها در عرض ناحیه ی تهی به سطح الکترود کنترل

η (Χ)	FF	Voc (V)	Jsc (mAcm ⁻²)	سمت ورود نور به سلول	نوع لايەنشانى پلاتين	توطيح	عنوان نمونه
۴/۲	•/81	۰/۷۳	٩/٣	کاتد	تجزیهی حرارتی روی FTO	هر دوزیرلایه FTO هستند. از عملیات ۲۱CL استفاده شده است. حرارت دهی ۳۰ دقیقه در ۴۷۰°C	FTO-TiCl ₄
۲/۶	۰/۳۸	·/Y1	٩/۶	کاتد	تجزیهی حرارتی روی FTO	زیرلایه ی فوتواند کروم است و لایهی متراکم تیتانیا ندارد. حرارت دهی ۳۰ دقیقه در ۲۰°۴۷	Cr–N
۴/۵	•/94	•/41	٩/۶	کاتد	تجزیه ی حرارتی روی FTO	زیرلایه ی فوتواند کروم است و لایهی متراکم تیتانیا روی آن لایه نشانی شده است. حرارتدهی ۳۰ دقیقه در ۴۷۰۰C	Cr–S
۶/۶۹	./9٣	۰/۷۳۵	14/42	فوتوآند	تجزیهی حرارتی روی FTO	سلول با ساختار متداول ، بدون پراکندهگر	FTO-Thermal Pt
۶/۲۳	•/۵۹	•/۶۹۵	14/48	فوتوآند	الکتروشیمیایی در ۲۵۰C	کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم	Cr−25 °C
A/YY	۰/۶۸	۰/۷۱۵	۱۸/۰۳	فوتوآند	الکتروشیمیایی در ℃۴۰	کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم	Cr−40 °C
٧/٩٩	•/94	./٧٢.	18/4	فوتوآند	الکتروشیمیایی در ۵۵°C	کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم	Cr−55 °C
۸/۸۳	./98.	·/Y).	19/70	فوتوآند	تجزیهی حرارتی روی FTO	سلول با ساختار متداول– در ساختار فوتوآند از پراکنده گراستغاده شده است.	FTO – Thermal Pt –S
٩/۵٢	./947	۰/۷۰۵	19/98	فوتوآند	الکتروشیمیایی در ۲۰۰۵	کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم- در ساختار فوتوآند از پراکندهگر استفاده شده است.	Cr–40 °C−S
٩/٢٣	•/\$41	./890	19/44	فوتوآند	الکتروشیمیایی در ۵۵۵C	کاتد دمای پایین با زیرلایه ی کروم- در ساختار فوتوآند از پراکندهگر استفاده شده است.	Cr−55 °C−S

در روش لایه نشانی الکتروشیمیایی با ولتاژ ثابت، چگالی نانوذرات پلاتین تشکیل شده روی سطح کم است درحالی که سایز آنها بزرگ است. در یك ولتاژ ثابت، وقتی فوق اشباعی در نزدیکی سطح رخ میدهد، هسته زایی روی سطح آغاز میشود. بعد از هسته زایی اولیه، غلظت یونها نزدیك سطح از حدی که بعد از هسته زایی اولیه، غلظت یونها نزدیك سطح از حدی که باعث ایجاد هسته زایی شود کم تر میشود، بنابراین فرآیند رشد برای هستههایی که قبلاً ایجاد شدهاند ادامه مییابد. برای ایجاد پرای هستههایی که قبلاً ایجاد شدهاند ادامه مییابد. برای ایجاد مرای پیش ماده در محلول لایه نشانی کم است، لازم است که شرایط لایه نشانی الکتروشیمیایی به گونه ای تنظیم شود که حالت فوق اشباعی برای هسته زایی های بعدی ادامه یابد. در لایه نشانی الکتروشیمیایی به صورت چرخه ای، شاریون هایی که از توده ی ماده به سمت سطح نفوذ میکنند با تغییر گامهای تغییر

مىشود. اين سيستم، سيستم نفوذ كنترل است و هسته هايي که روی سطح تشکیل شدهاند بزرگ تر می شوند. در واقع این مزیت روش لایه نشانی چرخه ای نسبت به روشهای لایه نشانی جریان ثابت و ولتاژ ثابت است که در هر چرخه هم هستهزایی و هم رشد رخ میدهد. در دماهای لایه نشانی بالاتر، جریان قله بزرگ تر است و نرخ هسته زایی به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. چگالی ذرات لایه نشانی شده با افزایش تعداد چرخهها افزایش مییابد. در لايه نشاني الكتروشيميايي

با ولتاژ ثابت، هسته زایی در ابتدای زمان لایه نشانی تشکیل می شود و در لحظات بعدی فرآیند رشد رخ می دهد. اما در لایه نشانی به روش چرخه ای در هر چرخه، هسته زایی جدید رخ می دهد. همچنین نانوذرات روی سطح زیرلایه، توزیع یکنواخت تری دارند و به ندرت به هم می چسبند. به طور متوسط چگالی نانوذرات در لبه های مکعب های کروم بیشتر است. دلیل این امر، نانوذرات در لبه های مکعب های کروم بیشتر است. دلیل این امر، قوی تر بودن میدان الکتریکی در لبه ها و مکان های تیز است. تعداد زیادی جایگاه رشد (kink یا و مکان های تیز است. وجود دارد که باعث رشد یکنواخت تر نانوذرات هنگام فرآیند لایه نشانی می شود. برای بررسی و مقایسه ی عملکرد کاتدهای ساخته شده با این روش، روی زیرلایه ی کروم لایه نشانی شده به روش الکتروشیمیایی و روی FTO، از سلول های خورشیدی رنگدانه

ای با استفاده از کاتد Cr-Pt (پلاتین لایه نشانی شده به روش لایه نشانی الکتروشیمیایی چرخهای) و با کاتد FTO-Pt (پلاتین لایه نشانی شده به روش حرارتی) ساخته شدند. در شکل (۱) نمودارهای چگالی جریان – ولتاژ این سلولها در مقایسه با هم نشان داده شده است.



شکل ۵) کا مودار چگالی جریان لایهنشانی پلاتین بر حسب ولتاژ اعمالی برای ۲۰ چرخه لایهنشانی در دمای ۲۰۰۵.

جدول (۱) ویژگیهای مشخصهی این سلولها را نشان میدهد. بیشترین بازدهی برای دمای لایه نشانی ^۲۰۰C به دست آمد. مشخصه های این سلول عبارت اند از: چگالی جریان ۱۸/۰ mA cm²، ولتاژ مدار باز ۷۱۵ /۷۱۸ ضریب پرکنندگی ۱۶/۸ و بازدهی٪۸/۷۷. برای این سلولها هیچ لایه ی پراکندهگری وجود ندارد. باز تابش پخشی از سطح کروم کم تر از مقدار مربوط به لایهی پراکنده گر تیتانیا (به عنوان مثال ذرات تیتانیا در فاز آناتاز و سایز ۱۵۰–۲۵۰ نانومتر) در هوا است، ولی بازتابش یخشی " از سطح پراکنده گر تیتانیا به طور قابل ملاحظه ای درون الکترولیت درون سلول خورشیدی رنگدانه ای به دلیل کم تر شدن اختلاف ضريب شكست تيتانيا و محيط اطراف تا به مقدار ۵۰٪ کاهش می یابد، بنابر این به نظر می رسد که لایه ی کروم تقریباً شبیه لایه ی پراکنده گر تیتانیا عمل میکند. برای نمونه ی لایه نشانی شده در دمای C°۵۵، سلول چگالی جریان نسبتاً کم تری را دارا است و این می تواند به دلیل تیره تر بودن سطح الکترود به دلیل لایه نشانی مقادیر بیشتر پلاتین است. ضریب پرکنندگی کمتر سلول متداول FTO-thermal Pt به دلیل بیشتر بودن مقاومت سری و مقاومت انتقال بار بیشتر، کمتر است. مقاومت انتقال بار (R_{et},Pt) و مقاومت سرى (Rs) براى الكترودهاى - Cr

Pt در دماهای C ۴۰°C و C ۵۵ به طور قابل ملاحظه ای کم است و c در بهترین حالت به $700\,{\rm C}$ میرسد.

یکی از آنالیزهای متداول برای بررسی کاتد، آنالیز ولتامتری چرخه ای در الکترولیت برپایه ی ید است. شکل (۶) نشان میدهد که خود لایه ی Cr و FTO به تنهایی خاصیت کاتالیستی لازم برای احیای -I_۲ در الکترولیت بر پایه ی ید سلول خورشیدی رنگدانهای را ندارد.

ولتاموگرامهای مربوط به کاتدهای Cr-Pt که با ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ چرخه در دمای C° ۲۵ لایه نشان ی شدهاند در شکل (۷) نمایش داده شدهاند.



شکل ۶ کا ولتاموگرامهای مربوط به لایههای کروم و FTO که پلاتین روی آنها لایه نشانی نشده است.



۵٬۱۰۵ و ۲۰ چرحه در دهای ۵ ۵۲ میه نسانی شدهاند در معایسه ب ولتاموگرام های کاتدهای با زیرلایه ی کروم و FTO که پلاتین روی آنها به روش حرارتی لایه نشانی شده است.

واكنش هایی كه در هریك از قله ها رخ می دهند عبارت اند از:

قلەھاى جريان كاتدى

a): $\Upsilon I_{\gamma} + \Upsilon e^{-} \rightarrow \Upsilon I_{\gamma}$

b): $I_r^- + \gamma e^- \rightarrow \gamma T^-$

قلههای جریان آندی

نانومقياس

ال دوم اشـمارهی چـهارم ازمـسـتـان ۱۳۹٤



شکل ۹) سلولهای رنگدانه ای باکاتدهای مختلف: a) فوتوالنترون برای فاقد پراکندهگر هستند. تفاوت کاتدهای کروم در تعداد چرخههای لایه نشانی است. b) سلولهای رنگدانه ای با کاتد با زیرلایهی کروم با پلاتین لایه نشانی شده در دماهای مختلف برای ۲۰ چرخه لایه نشانی، با لایهی پراکندهگر (با 8 نشان داده شده است) و بدون آن.

۴ نتیجهگیری

استفاده از کروم به عنوان زیرلایه ی کاتد و فوتوآند سلول خورشیدی رنگدانه ای میتواند باعث کاهش مقاومت سری سلول شود. همچنین در صورت لایه نشانی کروم روی فویل فلزی و حذف FTO روی شیشه، هزینه ی ساخت سلول به میزان قابل توجهي کم مي شود و اين زيرلايه مي تواند در سلول هاي خورشيدي انعطاف یذیر مورد استفاده قرار گیرد. برای کاهش مقاومت فصل مشترک کروم و تیتانیا، (در کاربرد کروم به عنوان زیرلایه ی فوتوآند) لایه نشانی سل نانوذرات تیتا مؤثر است و باعث افزایش ضریب پرکنندگی از ۰/۳۸ به ۰/۶۴ در اثر جلوگیری از ضخیم شدن لایه ی اکسیدی روی سطح کروم و اتصال بهتر لایه ی تیتانیا به لایه ی کروم می شود. به دلیل اتلاف نور در این ساختار و عدم امکان انجام عملیات TiCl₄ دوم روی آن و همچنین استفاده از لایهی پراکنده گر نوری، با استفاده از این ساختار تنها میتوان به بازدهی بیشینه ی ۴/۵٪ رسید. قلزی کردن زیرلایه ی کاتد می تواند اتلاف نور کم تری را سبب شود. برای کاهش پیچیدگی ساخت، کاتد دمای پایین که نیاز به حرارت دهی در دمای C ۴۰۰° را ندارد، با استفاده از فرآیند لایه نشانی چرخه ای مورد استفاده قرارگرفت. لایه نشانی پلاتین روی لبه های مکعب های ۶۰۰-۲۰۰ نانومتری کروم، به دلیل زیاد بودن میدان الکتریکی در لبهها، سبب تشکیل و توزیع یکنواخت تر نانوذرات پلاتین روی سطح می شود. با استفاده از این روش، کاتدی با مقاومت انتقال بار mA ۰/۴ cm² و ۰/۴ cm² برای لایه نشانی در دماهای به ترتیب ۴۰°C و C° ۵۵ به دست آمد که بازدهی ۸/۷۷٪ و ۷/۹۹٪ در سلول بدون یراکنده گر و بازدهی ۹/۲۳ و ۹/۵۲۶ در سلول با یراکندهگر تیتانیا را سبب می شود. d): $\Upsilon I_{r} \rightarrow I_{r} + e$

بیشینه شدن قله ی جریان مربوط به واکنش d و کمینه شدن اختلاف پتانسیل مربوط به قله ی d و c نشان دهنده ی بهبود کیفیت کاتد برای استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای است. همان طور که در شکل نشان داده شده است، برای تعداد چرخه ی کم تر از ۲۰، خاصیت الکتروکاتالیستی این کاتدها از مربوط به کاتدهایی که در دماهای مختلف لایه نشانی شدهاند در مقایسه با الکترود FTO-thermal Pt در شکل (۸) نمایش داده شدهاند. همان طور که در شکل (۸) نمایش داده شده است، در مورد کاتدهایی که در دماهای $0^{\circ} + 9$ و $0^{\circ} = 0$ ساخته شدهاند، مورد کاتدهایی که در دماهای $0^{\circ} + 9$ و $0^{\circ} = 0$ ساخته شدهاند، پتانسیل کاتدی به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از مقدار مربوط به جریان کاتدی به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از مقدار مربوط به پتانسیل قله ی d و c به میزان ۲۰ ولت می رسد که نشان دهنده ی

نمودارهای IPCEبرای سلولها با کاتدهای مختلف درشکل (۹) نشان داده شده است. همان طور که نشان داده شده است، در مورد نمونههایی که در آنها از لایه ی پراکنده گر تیتانیا استفاده نشده است و زیرلایه ی کاتد کروم است، IPCE در ناحیه ی آبی بیشتر است، و این می تواند به دلیل پراکندگی رایلی بیشتر در طول موجهای کوتاه ترازمکعبهای کروم (باسایزچندصدنانومتر) باشد.



شکل ۸ ♪】 ولتاموگرامهای مربوط به کاتدهای Cr–Pt که با ۲۰ چرخه در دماي ℃۲۵، ℃۴۰ و ℃۵۵ لايه نشانی شدهاند در مقايسه با ولتاموگرام های کاتدهای با زيرلايه ی کروم و FTO که پلاتين روی آنها به روش حرارتی لايه نشانی شده است.

- مراجع
- B. O'Regan and M. Grätzel, "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films," *Nature*, vol. 353, no. 6346, pp. 737–740, 1991.
- [2] B. E. Hardin, H. J. Snaith, and M. D. McGehee, "The renaissance of dye-sensitized solar cells," *Nat. Photonics*, vol. 6, no. 3, pp. 162–169, 2012.
- [3] K. Okada, H. Matsui, T. Kawashima, T. Ezure, and N. Tanabe, "100 Mm × 100 Mm Large-Sized Dye Sensitized Solar Cells," *J. Photochem. Photobiol. A Chem.*, vol. 164, no. 1–3, pp. 193–198, 2004.
- T. Ma, X. Fang, M. Akiyama, K. Inoue, H.
 Noma, and E. Abe, "Properties of several types of novel counter electrodes for dye-sensitized solar cells," *J. Electroanal. Chem.*, vol. 574, no. 1, pp. 77–83, 2004.
- [5] K. Miettunen, J. Halme, M. Toivola, and P. Lund, "Initial Performance of Dye Solar Cells on Stainless Steel Substrates," J. Phys. Chem. C, vol. 112, no. 10, pp. 4011–4017, 2008.
- [6] M. Toivola, F. Ahlskog, and P. Lund, "Industrial sheet metals for nanocrystalline dye-sensitized solar cell structures," *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, vol. 90, no. 17, pp. 2881– 2893, 2006.
- [7] M. Wu and T. Ma, "Platinum-free catalysts as counter electrodes in dye-sensitized solar cells," *ChemSusChem*, vol. 5, no. 8, pp. 1343–1357, 2012.
- [8] B. Fan, X. Mei, K. Sun, and J. Ouyang, "Conducting polymer/carbon nanotube composite as counter electrode of dye-sensitized solar cells," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 93, no. 14, pp. 91–94, 2008.
- [9] X. Huang, P. Shen, B. Zhao, X. Feng, S. Jiang, H. Chen, H. Li, and S. Tan, "Stainless steel mesh-based flexible quasi-solid dye-sen-sitized solar cells," *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, vol. 94, no. 6, pp. 1005–1010, 2010.

- [10] Y. Jun, J. Kim, and M. G. Kang, "A study of stainless steel-based dye-sensitized solar cells and modules," *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, vol. 91, no. 9, pp. 779–784, 2007.
- [11] C. M. Chen, C. H. Chen, and T. C. Wei, "Chemical deposition of platinum on metallic sheets as counterelectrodes for dye-sensitized solar cells," *Electrochim. Acta*, vol. 55, no. 5, pp. 1687–1695, 2010.
- [12] N. Fuke, A. Fukui, R. Komiya, A. Islam, M. Yanagida, R. Yamanaka, L. Han, and Y. Chiba, "New Approach to Low-Cost Dye-Sensitized Solar Cells With Back Contact Electrodes New Approach to Low-Cost Dye-Sensitized Solar Cells With Back," no. 3, pp. 4974–4979, 2008.
- [13] N. Fuke, R. Katoh, A. Islam, M. Kasuya,
 A. Furube, A. Fukui, Y. Chiba, R. Komiya, R.
 Yamanaka, L. Han, and H. Harima, "Influence of TiCl₄ treatment on back contact dye-sensitized solar cells sensitized with black dye," *Energy Environ. Sci.*, vol. 2, no. 11, p. 1205, 2009.
- [14] D. Fu, P. Lay, and U. Bach, "TCO-free flexible monolithic back-contact dye-sensitized solar cells," *Energy Environ. Sci.*, vol. 6, no. 3, p. 824, 2013.
- [15] F. Behrouznejad and N. Taghavinia, "Utilizing Chromium as the Photoanode Substrate in Dye-Sensitized Solar Cells," *ChemElectroChem*, vol. 1, no. 5, pp. 944–950, 2014.
- [16] F. Behrouznejad and N. Taghavinia, "High-performance/low-temperature-processed dye solar cell counter electrodes based on chromium substrates with cube-like morphology," J. Power Sources, vol. 260, pp. 299– 306, 2014.

Low-temperature Fabrication of Counter-electrode for Dye Solar Cells

F. Behrouznejad¹ | N. Taghavinia^{1,2}

1.Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Sharif University of Technology, Tehran, Iran 2.Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

Abstract

One of the biggest challenges in nano structure-based solar cells is fabricating low-temperature electrodes for decreasing fabrication cost and complexity and also utilizing them in flexible solar cells. In this research, electrochemically deposited Cr layer is introduced for using as a counter electrode's substrate. Increasing electrical field on edges and defects result in increasing the uniformity of platinum nanoparticles on the surface and enhancing the efficient surface area. Using this counter electrode, moreover than making the possibility of low-temperature fabrication, enhances large scale fabrication feasibility (due to the low series resistance of Cr in comparison with FTO/glass). Finally, the effect of utilizing Cr as a counter electrode substrate on the efficiency and fabrication limitation is studied in comparison with utilizing that as a photo-anode substrate. The maximum efficiency of 9.52% is obtained by using this low-temperature counter electrode in dye sensitized solar cell.

Keywords

Dye solar cells, Electrochemical deposition, Charge transfer resistance, Series resistance, Platinum nanoparticles.